

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成17年6月16日(2005.6.16)

【公開番号】特開2001-345294(P2001-345294A)

【公開日】平成13年12月14日(2001.12.14)

【出願番号】特願2000-163045(P2000-163045)

【国際特許分類第7版】

H 01 L 21/304

H 01 L 21/3065

【F I】

H 01 L 21/304 6 2 1 E

H 01 L 21/302 N

【手続補正書】

【提出日】平成16年9月17日(2004.9.17)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

半導体基板に、半導体素子を形成する半導体装置の製造方法において、前記半導体基板を含む被処理基板の正面の端部を選択的に研磨する工程を含むことを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項2】

前記被処理基板の正面の端部の研磨は、

該被処理基板に凹凸が形成される工程の後に行われることを特徴とする請求項1に記載の半導体装置の製造方法。

【請求項3】

前記被処理基板に凹凸が発生する工程が、ドライエッチング工程であることを特徴とする請求項2に記載の半導体装置の製造方法。

【請求項4】

前記被処理基板の正面の端部の研磨は、

前記半導体基板、或いは該被処理基板に対して所定の処理を行うプロセス装置の汚染となる材料の成膜工程の後に行われることを特徴とする請求項1に記載の半導体装置の製造方法。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0023

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0023】

【課題を解決するための手段】

[構成]

本発明は、上記目的を達成するために以下のように構成されている。

本発明は、半導体基板に、半導体素子を形成する半導体装置の製造方法において、前記半導体基板を含む被処理基板の正面の端部を選択的に研磨する工程を含むことを特徴とする。